

2P4M (SOT-89-3L)单向可控硅

n 特点:

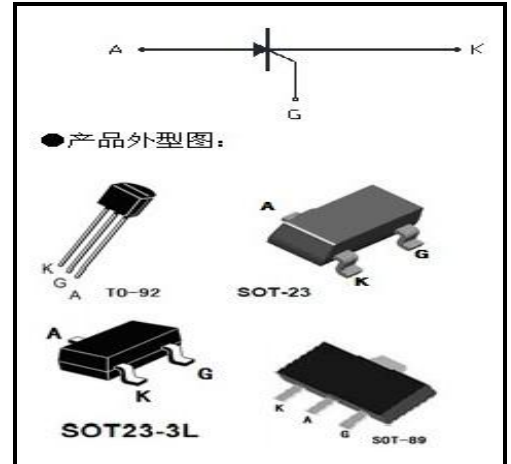
先进的台面玻璃钝化工艺, 单面台面结构, 具有门极灵敏触发, 触发电流一致性佳, 耐电流冲击能力强等特点。

n 用途:

广泛应用于各种万能开关器、小型马达控制器、彩灯控制器、漏电保护器、灯具继电器激励器、逻辑 集成电路驱动、大功率可控硅门极驱动、摩托车点火器等线路功率控制。

n 极限参数:

名称	符号	规范值	单位	测试条件
重复峰值阻断电压	V_{DRM}	>600	V	$I_{DRM}=20\mu A$
反向重复峰值电压	V_{DRM}	>600	V	$I_{RRM}=50\mu A$
通态电流	$I_{T(RMS)}$	2	A	正弦波, 180 度
浪涌电流	I_{TSM}	20	A	正弦波, 60HZ
结温	T_j	125	°C	----
储存温度	T_{stg}	-40~150	°C	----



n 电特性 ($T_j=25^\circ C$):

名称	符号	测试条件	Min	Max	单位
重复峰值阻断泄漏电流	I_{DRM}	$V_D=V_{DRM}$	----	0.1	mA
通态电压	V_{TM}	$I_T=1.0A$	----	1.7	V
门极触发电流	I_{GT}	$V_D=12V, R_L=100\Omega$	----	120	μA
门极触发电压	V_{GT}	$V_D=12V, R_L=100\Omega$	----	0.9	V
门极不触发电压	V_{GD}	$V_D=1/2 V_{DRM}$	0.2	----	V
断态电压临界上升率	dv_D/dt	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ Gate open $T_j=110^\circ C$	10	----	V/us